

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 光机电 >> 选择外延法制造源漏在绝缘体上的场效应晶体管

请输入查询关键词

科技频道

搜索

选择外延法制造源漏在绝缘体上的场效应晶体管

关键词: [绝缘体](#) [源漏](#) [场效应晶体管](#) [选择外延法](#)

所属年份: 2003

成果类型: 应用技术

所处阶段:

成果体现形式:

知识产权形式:

项目合作方式:

成果完成单位: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所

成果摘要:

该发明专利是一种源漏在绝缘体上的场效应晶体管(MOSFET)的制造方法,属于微电子技术领域。其特征为:采用选择外延法在常规SOIMOSTET器件的沟道下方埋氧中开一个窗口,使器件的沟道和硅衬底相连接,达到顶层硅和埋氧的刻蚀;在沟道区域选择外延单晶硅;化学机械抛光平坦化;常规CMOS工艺完成器件的制造等工艺步骤。采用该方法制造的源漏的绝缘体上的晶体,具有埋氧和体硅之间界面陡峭,缺陷少等优点,保证了器件的性能,在深亚微米集成电路的制造中有一定的应用前景。

成果完成人:

[完整信息](#)

行业资讯

- 塔北地区高精度卫星遥感数据处理
- 综合遥感技术在公路深部地质...
- 轻型高稳定度干涉成像光谱仪
- 智能化多用途无人机对地观测技术
- 稳态大视场偏振干涉成像光谱仪
- 2001年土地利用动态遥感监测
- 新疆特克斯河恰甫其海综合利...
- 用气象卫星资料反演蒸散
- 天水陇南滑坡泥石流遥感分析
- 综合机载红外遥感测量系统及...

成果交流

推荐成果

- [容错控制系统综合可信性分析...](#) 04-23
- [基于MEMS的微型高度计和微型...](#) 04-23
- [基于MEMS的载体测控系统及其...](#) 04-23
- [微机械惯性仪表](#) 04-23
- [自适应预估控制在大型分散控...](#) 04-23
- [300MW燃煤机组非线性动态模型...](#) 04-23
- [先进控制策略在大型火电机组...](#) 04-23
- [自动检测系统化技术的研究与应用](#) 04-23
- [机械产品可靠性分析--故障模...](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发布